

ZP/UR/80/2013

Zał. nr 1a do siwz

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- MODYFIKACJA Z DNIA 20.05.2013r.**

**Specjalista z zakresu technologii MBE**  
w ramach projektu *Wpływ punktu Diraca na stany*  
*elektronowe i fononowe w nanostrukturach na bazie związków*  
*półprzewodnikowych HgCdTe, HgZnT*

**Obowiązki Wykonawcy.**

1. Konsultacje przy uruchomieniu reaktora MBE dla wzrostu warstw związków II-VI (w skrócie reaktor II-VI).
2. Wzrost warstw dla nanostruktur związków HgCdTe i HgZnTe:
  - studni kwantowych na bazie heterostruktur HgCdTe/CdTe i HgCdTe/HgCdTe
  - studni kwantowych na bazie heterostruktur HgZnTe/ZnTe i HgZnTe/HgZnTe
3. Kontrola jakości otrzymanych nanostruktur metodami:
  - SIMS;
  - XRD;
  - pomiaru Holla – Van der Powa i normalne;
  - magnetotransport;
  - przepuszczalność w dalekiej podczerwieni
4. Konsultacje w przygotowaniu próbek pomiarowych z otrzymanych nanostruktur.